
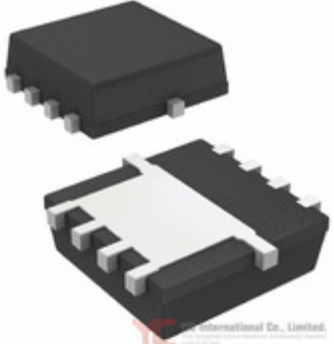
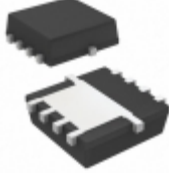
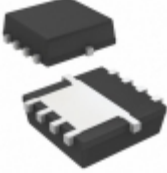

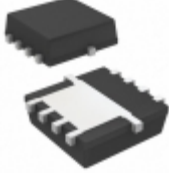
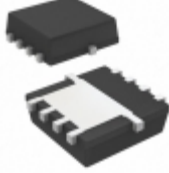
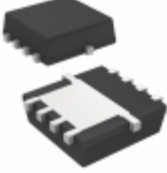


	<p>SIS447DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIS447DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 18A POWERPAK1212</p> <p>Datenblätter:  SIS447DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS447DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 18A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.1 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS447DN-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5590pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	181nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 18A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SIS447DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS447DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS447DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS447DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS443DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS443DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS444DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOP</p>	 <p>SIS448DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>
 <p>SIS452DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS448DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS448DN VB SIS448DN VB</p>	 <p>SIS448DN-T1-E3 VISHAY SIS448DN-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS447DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS447DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS447DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS447DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS447DN-T1-GE3
SIS447DN-T1-GE3 Electronic	SIS447DN-T1-GE3-Komponenten	SIS447DN-T1-GE3-Verteiler	SIS447DN-T1-GE3-Bild	SIS447DN-T1-GE3-Teil
SIS447DN-T1-GE3 Preis	SIS447DN-T1-GE3 Hersteller	SIS447DN-T1-GE3 Bild	SIS447DN-T1-GE3 Aktie	SIS447DN-T1-GE3 Inventar
SIS447DN-T1-GE3 Neu	SIS447DN-T1-GE3 Original	SIS447DN-T1-GE3 garantiert	SIS447DN-T1-GE3 RFQ	SIS447DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited